ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДЕФЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ Р-I-N-ФОТОПРИЕМНИКОВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩЕЕ S-ОБРАЗНОСТЬ ИХ ВАХ

Свиридова О. В., к.ф.-м. н., м.н.с. Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Одесса

Образование дефектов в готовых фотоприемных р-i-n-структурах происходит как в процессе формирования исходных пластин и промежуточных структур, так и в процессе технологической обработки, сопровождающейся большим количеством температурных и химических воздействий, что приводит к ухудшению параметров готовых структур.

Установлено (Рисунок 1), что отбор p-i-n-фотоприемников по наличию или отсутствию S-образности ВАХ может быть использован

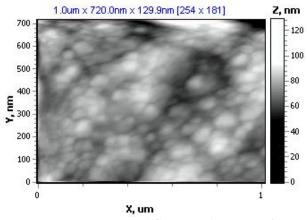


Рисунок 1 – Латеральное ACM- изображение (NT-206) мелкоблочной структуры на глубине 0.3 мкм от внешней поверхности p-i-n-фотоприемника

для выявления фотоприемников, содержащих области разупорядочения в виде поликристаллического кремния.